

3DG162 型 NPN 硅高频小功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值										单 位
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
极 限 值	P_{CM}		300										mW
	I_C		20										mA
	T_{jm}		175										℃
直 流 参 数	$V_{(BR)CB}$	$I_{CB}=0.1mA$	≥6	≥10	≥14	≥18	≥22	≥6	≥10	≥14	≥18	≥22	V
	$V_{(BR)CE}$	$I_{CE}=0.1mA$	≥6	≥10	≥14	≥18	≥22	≥6	≥10	≥14	≥18	≥22	V
	$V_{(BR)EB}$	$I_{EB}=0.1mA$	≥5.0										V
	I_{CBO}	$V_{CB}=30V$	≤0.1										μA
	I_{CEO}	$V_{CE}=2V$	≤0.1										μA
	I_{EBO}	$V_{EB}=30V$	≤0.1										μA
	V_{BEsat}	$I_C=10mA$	≤1										V
	V_{CEsat}	$I_B=1mA$	≤0.5										
	h_{FE}	$V_{CE}=10V$ $I_C=2mA$	≥20										
交 流 参	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=2mA$ $fo=30MHz$	≥50				≥100						MH z
外 引 线 说 明	 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极 A3-01(B1)												
替代型号:													